

关键指标

频率: 2~6GHz
 饱和输出功率: 32dBm@Pin=8dBm
 功率附加效率: 33%@Pin=8dBm
 功率增益: 24dB@Pin=8dBm
 电压/静态电流: +8V/380mA
 芯片尺寸: 2.45mm×2.04mm

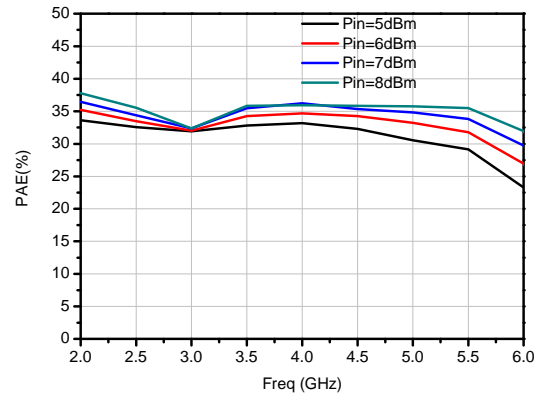
产品简介

HG134F3 是一款 2~6GHz 宽带功率放大器芯片, 饱和输出功率为 32dBm, 采用双电源供电, 输入输出端已集成隔直电容。

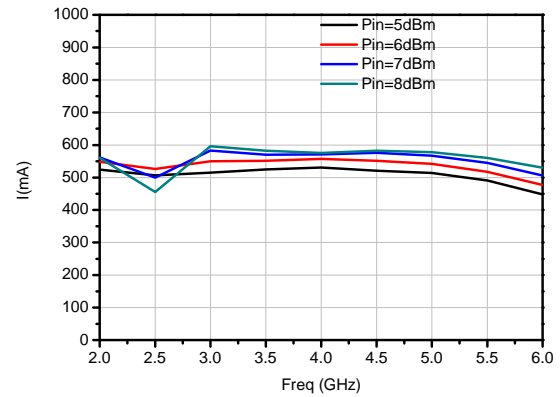
电性能 (TA=25°C, VD=8V, VG=-0.65V, Pin=8 dBm, 连续波)

指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	2~6		
功率增益(dB)	-	24	-
功率增益平坦度(dB)	-	±0.5	-
输入驻波	-	1.6	-
饱和输出功率(dBm)	-	32	-
功率附加效率(%)	-	33	-
静态电流	-	380	-

功率附加效率

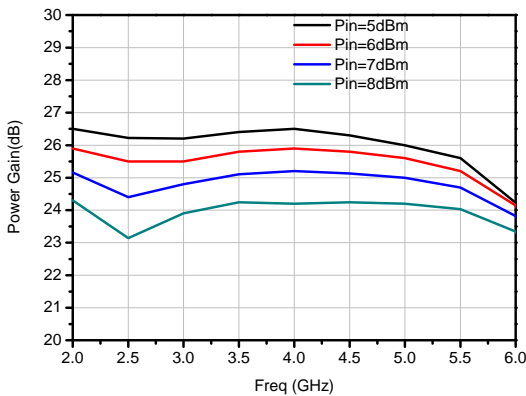


动态电流

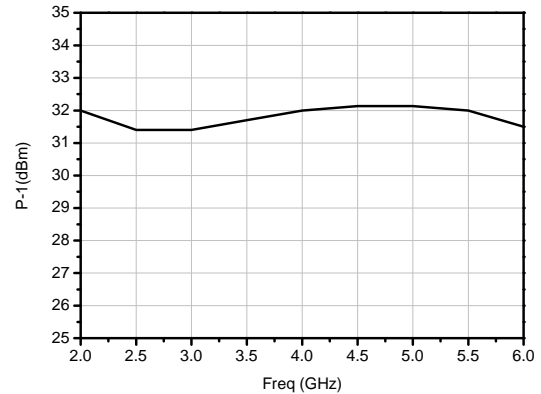


典型测试曲线

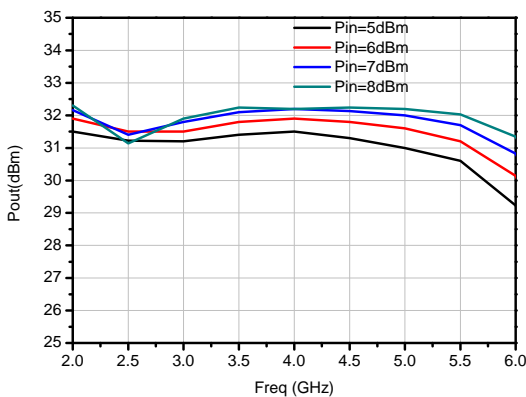
功率增益



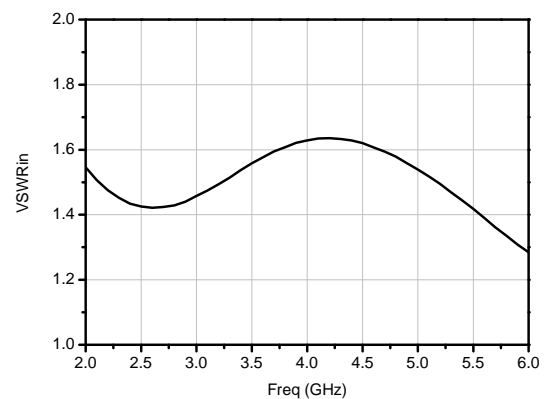
1dB 压缩点输出功率



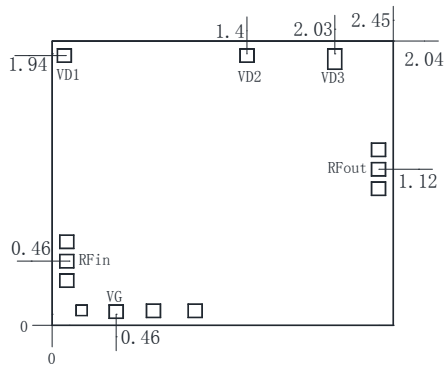
输出功率



输入驻波



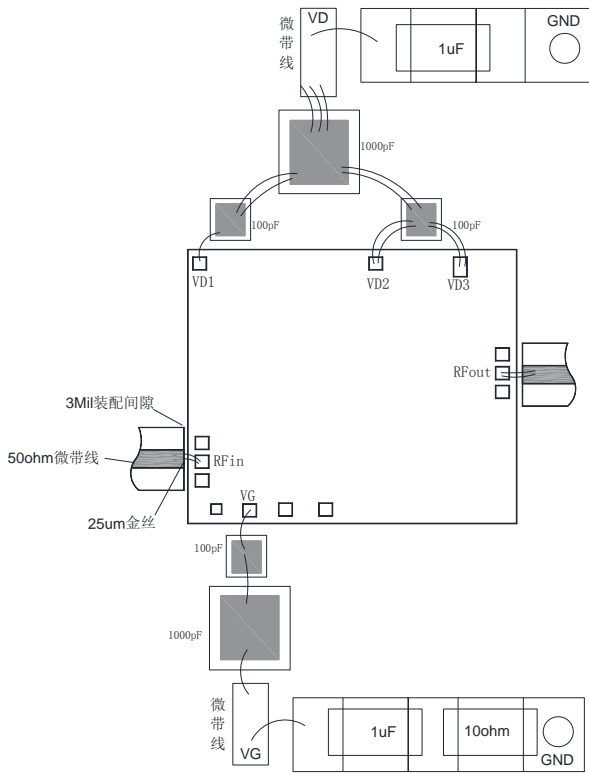
外形和端口尺寸 (mm)



金带键合, 建议金带长度 250~400 μ m;

5. 芯片微波端有隔直电容;
6. 芯片对静电敏感, 在储存和使用过程中注意防静电。

推荐装配图



绝对额定最大值

电源电压	+10V
最大输入功率	+20dBm
工作温度	-55 $^{\circ}$ C ~ 85 $^{\circ}$ C
存储温度	-65 $^{\circ}$ C ~ 150 $^{\circ}$ C

注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储, 在超净环境使用;
2. GaAs 材料较脆, 不能触碰芯片表面, 使用时必须小心;
3. 芯片用合金烧结 (合金温度不能超过 300 $^{\circ}$ C, 时间不能超过 30 秒), 使之充分接地;
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm, 使用 50 μ m 双